

## Сведения о ведущей организации

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование ведущей организации  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипяна Российской академии наук   |
| Сокращенное наименование ведущей организации   | ИФТТ РАН   |
| Организационно-правовая форма ведущей организации  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки   |
| Ведомственная принадлежность ведущей организации   | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  |
| Местонахождения ведущей организации, её почтовый адрес; Телефон;<br>Адрес электронной почты;<br>Сайт ведущей организации в сети Интернет   | Россия, 142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул. Академика Осипяна д. 2<br><br>Телефон:<br>8(496)52 219-82<br>+7 906 095 4402<br>E-mail: <a href="mailto:adm@issp.ac.ru">adm@issp.ac.ru</a><br>Сайт в сети Интернет: <a href="http://www.issp.ac.ru">http://www.issp.ac.ru</a>  |
| Руководитель организации   | Левченко Александр Алексеевич  |
| Уполномоченный   |  |
| Должность  | Директор   |
| Ученая степень   | доктор физ.-мат. наук  |
| Ученое звание  | член-корреспондент РАН   |
| Список основных публикаций сотрудников ведущей организации по тематике рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет (2019-2024), не более 15-ти публикаций | <p>Dorokhin, M.V. Circularly Polarized Electroluminescence of InGaAs/GaAs/CoPt Spin Light Emitting Diodes Placed in a Strong and Weak Magnetic Field / M.V. Dorokhin, P.B. Demina, A.V. Zdoroveyshchev, S.V. Zaitsev, A.V. Kudrin // Technical Physics (Springer). – 2023. – Vol. 68, Iss. 3 supplement. – P. S418–S423</p> <p>Соловьев, В.В. Исследования гетероструктур GaN/AlGaN методами оптической спектроскопии для фундаментальной науки и практических приложений / В.В. Соловьев, И.В. Кукушкин // 3-я Школа молодых ученых "Новые материалы и технологии для систем безопасности" : сб. тр. (31 мая - 3 июня 2021) / Черноголовка. – 2021. – С. 21.</p> <p>Orlov, V.I. Estimations of Activation Energy for Dislocation Mobility in p-GaN / V.I. Orlov, A.Y. Polyakov, P.S. Vergeles, E.B. Yakimov, Gyu Cheol Kim, In-Hwan Lee // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2021. – Vol. 10, Iss. 2. – P. 26004.</p> <p>Solovyev, A.A. Light-tunable 2D subband population in a GaN/AlGaN heterostructure / V.V. Solovyev, S. Schmelt, L. Krückeberg, A. Großer, T. Mikolajick, I.V. Kukushkin //</p> |

Исполнитель – Терещенко А.Н.  
Телефон: 8 496 522 46 85

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Applied Physics Letters. – 2021. – Vol. 18, Iss. 1. – P. 13101.</p> <p>Krückeberg, L. Quantum and transport lifetimes in optically induced GaN/AlGaN 2DEGs grown on bulk GaN / L. Krückeberg, S. Wirth, V.V. Solovyev, A. Großer, I.V. Kukushkin, T. Mikolajick, S. Schmult // Journal of Vacuum Science and Technology B. – 2020. – Vol. 38, Iss. 4. – P. 42203.</p> <p>Соловьев, В.В. Гетероструктуры GaN/AlGaN: новые фундаментальные свойства и их практические приложения / В.В. Соловьев, И.В. Кукушкин // 2-я Школа молодых ученых «Новые материалы и технологии для систем безопасности» : сб. тр. – 2020. – С. 22.</p> <p>Vergeles, P.S. Comparative Study of Optical and Electrical Properties of Grown-In and Freshly Introduced Dislocations in GaN by SEM Methods / P.S. Vergeles, E.B. Yakimov, V.I. Orlov // Journal of Electronic Materials. – 2020. – Vol. 49, Iss. 9. – P. 5173-5177.</p> |
|--|--|

Директор ИФТТ РАН  
член-корр. РАН, д.ф.-м.н.



А.А. Левченко

Исполнитель – Терещенко А.Н.  
Телефон: 8 496 522 46 85